



2026 年 1 月 13 日

Patentix, 第 40 回ネプコン展に初出展

～次世代パワー半導体素材、ルチル型二酸化ゲルマニウム「r-GeO₂」の実用化・普及を目指す～

Patentix 株式会社（本社：滋賀県草津市、代表取締役社長：衣斐豊祐、以下「Patentix」）は、2026 年 1 月 21 日（水）～23 日（金）までの 3 日間、東京ビッグサイトで開催される「第 40 回ネプコンジャパンパワーエレクトロニクス&モジュール EXPO 展」に初出展します。本展示会は、エレクトロニクス機器の多機能化・高性能化を支える最新の電子部品・材料や製造技術・実装技術が集まるアジア最大規模の展示会です。

近年、生成 AI の急速な普及により、データセンターでは膨大な電力消費を余儀なくされ、それに伴いインフラ設備も、電源冷却用に大量の水を必要とするといったこれまでにない難しさを抱えています。また中国では新車販売の半数以上は EV と云われており、両者とも電源の更なる効率化は喫緊の課題となっております。当社ブースでは、「次世代パワー半導体素材として、最近注目をあびているルチル型二酸化ゲルマニウムの社会実装」をテーマに、素材の可能性・優位性について幅広く展示します。具体的には、他素材との特性比較、これまでに達成した成果、例えば、SBD（ショットキーバリアダイオード）の動作確認、最新の研究開発状況、例えば、高耐圧 300V での SBD の静特性（I-V 特性）の紹介、更には近々発売開始予定の小片基板サンプルの実物も一部展示いたします。

また、今後の開発予定につきましてもご紹介いたします。当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。尚、当社ブースは E36-58 となります。

【本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Patentix 株式会社 広報担当：樋口 典子

E-mail: info@patentix.co.jp

電話番号：077-599-1558

